

будут пространственно разнесены (рис. 1). Коэффициент отражения для Е- и Н-поляризаций при этом равен коэффициенту отражения этих поляризаций в случае компланарного рассеяния [3].

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Rebuffi L. Metallic plates lens focalizing a high power microwave beam, CEA EURATOM, EUR - CEA - FC - 1332, aout, 1987.
- [2] Борн М., Вольф Э. Основы оптики. М.: Наука, 1970.
- [3] Electromagnetic theory of gratings / Ed. by R. Petit Berlin - Heidelberg - N.Y.: Springer - Verlag, 1980.
- [4] Вайнштейн Л.А., Суков А.И. // Радиотехн. и электрон. 1984. Т. 29. В. 8. С. 1472.

Институт прикладной
физики АН СССР,
Горький

Поступило в Редакцию
26 июля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 20

26 октября 1989 г.

02; 12

СПЕКТРОСКОПИЯ МЕЖАТОМНЫХ ВЗАЙМОДЕЙСТВИЙ МЕТОДОМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ

Ю.Н. М о и с е е в, В.М. М о с т е п а н е н к о,
В.И. П а н о в, И.Ю. С о к о л о в

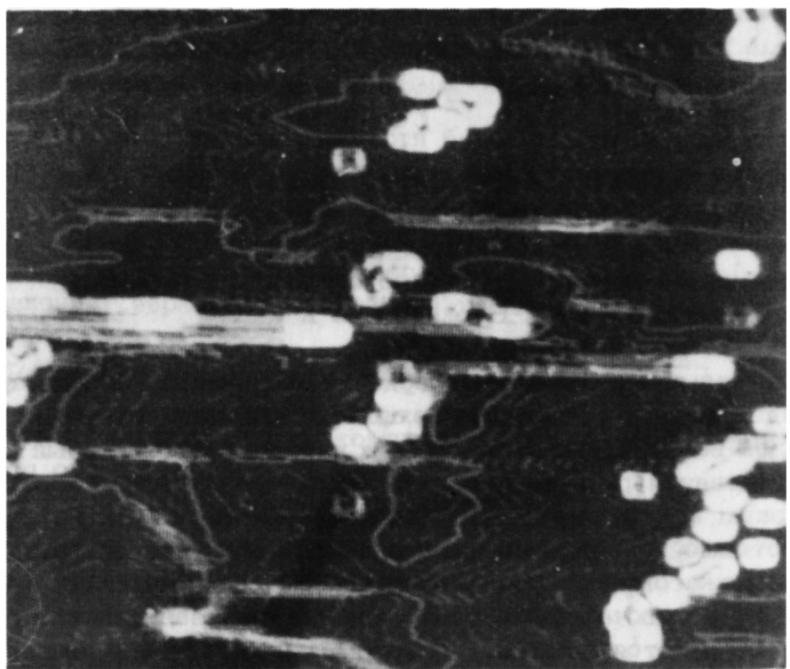
Метод атомно-силовой микроскопии, основанный на измерении сил Вандер-Ваальса между поверхностью твердого тела и подносимым к ней на расстояние нескольких ангстрем острием, был развит для исследования рельефа поверхности любых веществ с разрешением, близким к атомному [1-3].

В настоящей работе этот метод использован для локальной спектроскопии межатомных взаимодействий (такая возможность обсуждалась в [4]), включающей в себя определение зависимости межатомных сил от расстояния между острием и плоскостью и вычисление констант этих взаимодействий.

Измерения проводились по схеме, описанной ранее в [2, 3]. В этой схеме основным элементом служит острие, к которому с помощью трехкоординатного пьезоманипулятора подводится поверхность исследуемого образца. Острие закреплено на пружине, имеющей малую механическую жесткость, которая изгибается за счет силового взаимодействия между атомами острия и поверхности в процессе сканирования образца под иглой. Датчик, регистрирующий прогиб

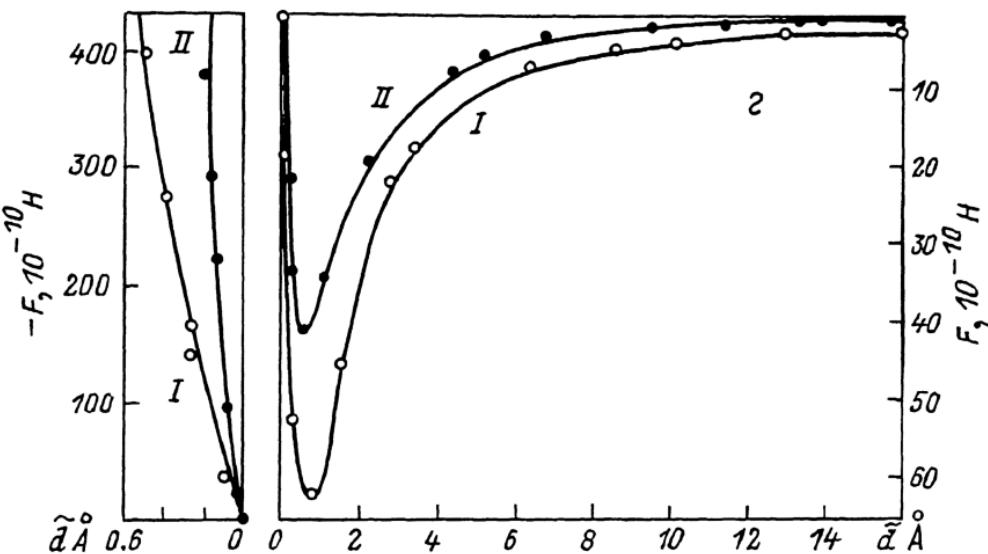
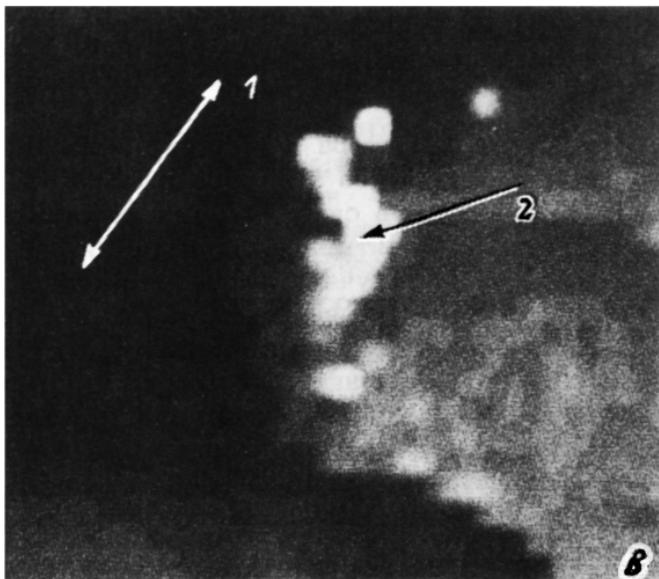


α



β

в – изображение участка 10×10 нм. Стрелками указаны области для которых измерялась зависимость $F(\tilde{d})$. Области, соответствующие: 1 – кривой I, 2 – кривой II (см. рисунок, г).



Продолжение рисунка.

пружины, формирует изображение рельефа поверхности постоянной силы.

Определение силы взаимодействия между острием и выбранным участком поверхности от расстояния между ними производилось по величине прогиба пружины (в полосе частот 5 Гц при фиксированном в плоскости поверхности положении острия).

На рисунке, а приведено изображение рельефа поверхности склона диэлектрического кристалла лейкосапфира, полученного при постоянной величине силового взаимодействия $F \approx 2.5 \cdot 10^{-9}$ Н. Участок поверхности имеет площадь 25×25 нм, причем переход от темного поля к светлому соответствует перепаду высот 4 нм.

На рисунке, б для того же участка показано изображение вариаций силы по нормали к поверхности. Из рисунка, а, б видно, что поверхность имеет локализованные области размером 1 нм, над которыми происходит резкое изменение силового взаимодействия с острием АСМ.

С целью определения характера и констант межатомного взаимодействия для различных участков этой поверхности (см. рисунок, в) была измерена зависимость силы $F(\tilde{d})$ от расстояния \tilde{d} между острием и поверхностью, отсчитываемого от точки нулевой силы. Кривая I (см. рисунок, г) получена для бездефектного участка поверхности, кривая II измерена непосредственно над локализованным дефектом. Приведенные средние величины $F(\tilde{d})$ получены как при сближении, так и при удалении поверхности и острия. Развитая методика позволяет найти основные константы, определяющие потенциальную энергию взаимодействия исследуемых веществ. С этой целью воспользуемся потенциалом Леннард-Джонса [5], описывающим взаимодействие Ван-дер-Ваальса между отдельными атомами (молекулами): $V(r) \sim \left(\frac{r_0}{r}\right)^{12} - b\left(\frac{r_0}{r}\right)^6$, где b – постоянная, зависящая от типа молекул, $r_0 \approx 0.3\text{--}0.4$ нм. Силы отталкивания, отвечающие первому слагаемому $V(r)$, быстро спадают с расстоянием и действуют только лишь при $r < 0.4$ нм между теми атомами острия и образца, которые непосредственно взаимодействуют друг с другом. Поэтому полная сила отталкивания может быть представлена в виде $\frac{dN}{d^3}$, где N – число атомов на конце острия, α – константа обменного взаимодействия. Если $d > 0.4$ нм, то отталкиванием можно пренебречь, а сила притяжения определяется суммированием потенциалов с зависимостью $\sim r^{-6}$, действующих между парами молекул острия и образца. Как показано в работе [3], она имеет вид $\sim \frac{\pi CR}{d^2}$ (R – радиус кривизны острия, C – константа ван-дер-ваальсовского взаимодействия) и сохраняется вплоть до $d \lesssim 10$ нм. В результате во всем диапазоне расстояний $0 < d \lesssim 10$ нм силовое взаимодействие между острием и поверхностью можно представить в виде

$$F = \frac{\alpha N}{d^3} - \frac{\pi CR}{d^2}. \quad (1)$$

Отметим, что в работе [6] первое слагаемое в формуле типа (1), полученное интегрированием потенциала $\sim r^{-12}$ по объему острия и образца, имеет зависимость от расстояния r^{-8} . Этот результат является ошибочным, так как зависимость $\sim r^{-12}$ имеет место лишь при $r \lesssim r_0$, а для $r > r_0$ вследствие более быстрого уменьшения обменных сил интегрирование по объему не дает вклада в силу отталкивания.

В формуле (1) расстояние d связано с измеряемым значением соотношением $d = \tilde{d} + \Delta$. Сдвиг шкалы расстояний Δ , под-

лежащий определению, включает в себя поправку, вызванную упругой деформацией острия и поверхности. Максимальная величина этой поправки, оцененная по методике работы [7], не превышает $1.5 \cdot 10^{-2}$ нм. Погрешность ее определения находится в пределах ошибки измерения d .

Определение неизвестных параметров $CR, \alpha N$ и A в аналитической зависимости (1) производилось путем ее сопоставления с экспериментальными результатами $F(\tilde{d})$, представленными для двух участков поверхности на рисунке, г.

Для тех областей поверхности исследуемого образца (см. рисунок, г, кривая I), где отсутствуют дефекты, были получены следующие значения параметров:

$$\begin{aligned} A_1 &= 0.24 \pm 0.01 \text{ нм}, \\ CR &= (1.8 \pm 0.3) \cdot 10^{-28} \text{ Дж. м}, \\ (\alpha N)_1 &= (7 \pm 2) \cdot 10^{-17} \text{ Н/нм}^3. \end{aligned} \quad (2)$$

Для областей поверхности, расположенных непосредственно над локализованными дефектами (см. рисунок, г, кривая II), те же параметры имеют значения

$$\begin{aligned} A_2 &= 0.25 \pm 0.01 \text{ нм}, \\ CR &= (1.2 \pm 0.2) \cdot 10^{-28} \text{ Дж. м}, \\ (\alpha N)_2 &= (11 \pm 2) \cdot 10^{-17} \text{ Н/нм}^3. \end{aligned} \quad (3)$$

Радиус острия R определялся по методике, описанной ранее в работе [3]. Его средняя величина в настоящих экспериментах составляла ≈ 10 нм. В результате численные значения констант ван-дер-ваальсовских взаимодействий C составили

$$C_1 = (1.8 \pm 0.3) \cdot 10^{-20} \text{ и } C_2 = (1.2 \pm 0.2) \cdot 10^{-20} \text{ Дж.}$$

Проанализируем полученные результаты. Найденные константы указывают на увеличение отталкивания между острием и поверхностью, где наблюдаются локализованные аномалии. Кроме того, приведенное в настоящей работе значение константы C_1 отличается от рассчитанной в [8] величины $C = (0.88 \pm 0.05) \cdot 10^{-20}$ Дж для тех же взаимодействующих веществ $Al_2O_3 - Al_2O_3$. Совокупность этих результатов позволяет предположить присутствие дополнительных электрических зарядов одного знака на конце острия и в местах локализованных аномалий. В самом деле, такие заряды должны вызывать дополнительное притяжение и приводить к увеличению константы C над бездефектными участками поверхности, а над локализованными дефектами вызывать дополнительное кулоновское отталкивание. Сопоставив наблюдаемое и рассчитанное значения C , можно определить величину избыточного заряда на конце зондирующего острия:

$$Q_0 = 2 \left[\frac{\epsilon + 1}{\epsilon - 1} \pi R (C_1 - C_2) \right]^{1/2} \simeq 2 (1.9 \pm 0.4) \cdot 10^{-19} \text{ Кл} \simeq 2 \text{ е}$$

(ϵ – диэлектрическая проницаемость лейкосапфира). Аналогичная оценка, полученная с учетом не только потенциала изображения, но и кулоновского взаимодействия зарядов, может быть дана для заряда Q_n , локализованного на поверхности: $Q_n \approx (9.8 \pm 0.2)e$.

Таким образом, метод атомно-силовой микроскопии позволяет определять значения констант межатомных взаимодействий и выявлять наличие локализованных зарядов на поверхности твердого тела в масштабах, близких к атомным.

Авторы выражают благодарность Ю.С. Барашу и Л.В. Келдышу за консультации и стимулирующие дискуссии.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Binning G., Quate C.F., Cerber Ch. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 56. N 10. P. 930–933.
- [2] Васильев С.И., Леонов В.Б., Моисеев Ю.Н., Панов В.И. // Письма в ЖТФ. 1988. Т. 14. В. 8. С. 727–731.
- [3] Moiseev YuN., Mostepanenko V.M., Panoy V.I., Sokolov I.Yu. // Phys. Lett. 1988. V. 132A. N 6, 7. P. 354–358.
- [4] Моисеев Ю.Н., Мостепаненко В.М., Панов В.И. // Тез. докл. VI Всес. симп. по растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования твердых тел. Звенигород, 1989. С. 204.
- [5] Harrison W.A. // Phys. Rev. B. 1981. V. 23. N 10. P. 5230–5245.
- [6] Yamada H., Fujii T., Nakayama K.J. // Vac. Sci. Technol. 1988. V. A6. N2. P. 293–295.
- [7] Soler J.M., Baro A.M., Garcia N., Rohrer H. // Phys. Rev. Lett. 1986. V. 57. N 4. P. 444–447.
- [8] Krupp H., Schnabel W., Walter G. // J. Coll. J. Sci. 1972. V. 39. N 2. P. 421–423.

Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова

Поступило в Редакцию
31 июля 1989 г.